

Horaire	Lundi 13 novembre 2017
13:30 13:45	Accueil à l'ENSE3, bât. GreEn-ER, 21 rue des Martyrs 38031 Grenoble cedex 1 Introduction
14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 14:50 14:50 – 15:10 15:10 – 15:30	Session 1 : Dispositifs pour l'Energie et la Détection (chairman : Y. Coffinier) <u>Invité 1</u> : T. Pauporté, <i>Chimie Paris Tech</i> , « Electrochemical Growth of ZnO Nanowires Applied to Nanosensors » <u>Oral 1</u> : T. Le, <i>CEA-INAC</i> , « Étude électrogravimétrique du stockage électrochimique dans des électrodes à base de nanofils de silicium » <u>Oral 2</u> : M. Al-Ghzaiwat, <i>LPICM</i> , « Mini-modules based on radial junction silicon nanowire solar cells grown on FTO/glass substrates » <u>Oral 3</u> : O. Burchak, <i>ENWIRES</i> , « Mass synthesis of silicon nanowires for their application in Li-ion batteries »
15:30	Pause-café
16:00 16:00 – 16:30 16:30 – 16:50 16:50 – 17:10 17:10 – 17:30	Session 2 : Caractérisations et Propriétés 1 (chairman : J. Pernot) <u>Invité 2</u> : J. Claudon, <i>CEA-INAC</i> , « Une boîte quantique intégrée dans un nanofil semiconducteur : une nouvelle plateforme pour l'optique quantique et la nanomécanique hybride » <u>Oral 4</u> : L. Mancini, <i>C2N</i> , « Optical properties of grown-on-graphene GaN nanowires » <u>Oral 5</u> : F. Donatini, <i>Institut Néel</i> , « Exciton diffusion coefficient in ZnO nanowires » <u>Oral 6</u> : M. Amato, <i>C2N</i> , « Crystal phase effects in group IV nanowire polytypes and their homojunctions »
17:30	Pause
17:40 17:40 – 18:10 18:10 – 18:30 18:30 – 18:50	Session 3 : Dispositifs pour la Nanoélectronique (chairman : B. Salem) <u>Invité 3</u> : S. Barraud, <i>CEA-LETI</i> , « Enjeux et avancées technologiques des transistors MOSFET à nanofils » <u>Oral 7</u> : E. Eustache, <i>LTM</i> , « Fabrication and characterization of horizontal and vertical GeSn nanowires using a top-down approach for future CMOS generations » <u>Oral 8</u> : E. Azrak, <i>GPM, LPICM</i> , « Growth of in-plane Ge-Sn nanowires by solid-liquid-solid mechanism »
18:50	Fin des présentations

Horaire	Mardi 14 novembre 2017
08:50	Accueil à l'ENSE3, bât. GreEn-ER, 21 rue des Martyrs 38031 Grenoble cedex 1
9:00 9:00 – 9:30 9:30 – 9:50 9:50 – 10:10 10:10 – 10:30	Session 4 : Croissance 1 (chairman : S. Plissard) <u>Invité 4</u> : B. Alloing, <i>CRHEA</i> , « GaN nanowires by selective area approaches » <u>Oral 9</u> : F. Glas, <i>C2N</i> , « Comparison of modeling strategies for the growth of heterostructures in III-V nanowires » <u>Oral 10</u> : J. Cibert, <i>Institut Néel</i> , « Croissance et sublimation de nanofils : boîtes quantiques CdTe dans ZnTe » <u>Oral 11</u> : F. Oehler, <i>C2N</i> , « Growth dynamics of self-catalyzed GaP nanowires arrays grown by MBE »
10:30	Pause-café
11:00 11:00 – 11:30 11:30 – 11:50 11:50 – 12:10 12:10 – 12:30	Session 5 : Dispositifs pour la Détection et l'Energie (chairman : V. Sallet) <u>Invité 5</u> : Y. Coffinier, <i>IEMN</i> , « Fabrication et fonctionnalisation de nanofils de silicium pour des applications santé et environnementales » <u>Oral 12</u> : X. Guan, <i>INL</i> , « GaAs/TiO ₂ core-shell nanowires for solar water splitting » <u>Oral 13</u> : T. Nguyen, <i>LMGP</i> , « Nanonets semiconducteurs : De la conception à l'intégration en dispositifs électroniques pour la détection de biomolécules » <u>Oral 14</u> : A.C. Salaün, <i>IETR</i> , « Résistances à base de nanofils de silicium pour la détection de bactéries »
12:30	Repas Buffet : salle de restauration
14:00 14:00 – 14:20 14:20 – 14:40 14:40 – 15:00 15:00 – 15:20 15:20 – 15:40	Session 6 : Caractérisations et Propriétés 2 (chairman : M. Tchernycheva) <u>Oral 15</u> : G. Brémond, <i>INL</i> , « Measurement considerations on doping profiles by scanning probe microscopy on semiconductor nanowires and nanostructures » <u>Oral 16</u> : A.M. Siladie, <i>CEA-INAC</i> , « p-n junction visualization and quantitative characterization on single Al _x Ga _{1-x} N nanowires » <u>Oral 17</u> : N. Chauvin, <i>INL</i> , « Optical polarization properties of wurtzite InP and InAs/InP nanowires grown on silicon (111) » <u>Oral 18</u> : D. Beznasiuk, <i>Institut Néel</i> , « Strain distribution along an axial InGaAs/GaAs nanowire heterostructure » <u>Oral 19</u> : M. Den Hertog, <i>Institut Néel</i> , « In-situ biasing and off-axis electron holography of a ZnO nanowire »
15:40	Pause-café

<p>16:15 16:15 – 16:45 16:45 – 17:05 17:05 – 17:25 17:25 – 17:45</p>	<p>Session 7 : Dispositifs pour l'Optoélectronique (chairman : J. Eymery) <u>Invité 6</u> : P. Gilet, <i>ALEDIA</i>, « Nanofils : d'un objet scientifique à la création d'un composant électronique grand public » <u>Oral 20</u> : N. Guan, <i>C2N</i>, « Flexible LEDs based on III-Nitride core-shell nanowire LEDs » <u>Oral 21</u> : T. Cossuet, <i>LMGP</i>, « ZnO / Sb₂S₃ core shell nanowire heterostructures for ETA solar cells » <u>Oral 22</u> : A. Fave, <i>INL</i>, « HETONAN project: High efficiency tandem solar cells based on III-V nanowires on silicon »</p>
<p>17:45</p>	<p>Session Posters et cocktail dinatoire <u>P1</u> : M. Vettori, <i>INL</i>, « Ordered arrays of GaAs/AlGaAs nanowires for photovoltaic cells » <u>P2</u> : M. Foldyna, <i>LPICM</i>, « In-situ study of nanowire growth by spectral ellipsometry » <u>P3</u> : J. Tang, <i>C2N</i>, « Growth of anisotropic quantum dots in thin III-V nanowires » <u>P4</u> : X. Guan, <i>INL</i>, « GaAs Core / SrTiO₃ shell nanowires grown by molecular beam epitaxy » <u>P5</u> : C. Verrier, <i>LMGP</i>, « Tunable morphology and pH-dependent doping of ZnO nanowires grown by chemical bath deposition » <u>P6</u> : S. Hassani, <i>GEMaC</i>, « Structural properties and ordering studies in Zn_{1-x}Mg_xO alloys grown by MOVPE » <u>P7</u> : P. Chenevier, <i>CEA-INAC</i>, « Mass production of silicon nanowires » <u>P8</u> : G. Amiri, <i>GEMaC</i>, « MOCVD growth and optical characterization of ZnTe/ZnMgTe core-shell nanostructures » <u>P9</u> : T. Cossuet, <i>LMGP</i>, « Polarity-dependent selective area growth and physical properties of ZnO nanorods by chemical bath deposition » <u>P10</u> : R. Fons, <i>CEA-INAC</i>, « Détermination optique de la position de boîtes quantiques semiconductrices intégrées dans un fil photonique » <u>P11</u> : K. Kheng, <i>CEA-INAC</i>, « Vertical CdSe/ZnSe nanowire-quantum dots and enhanced photon extraction with a bottom-up photonic shell » <u>P12</u> : J. Eymery, <i>CEA-INAC</i>, « X-ray for nitride wires » <u>P13</u> : G. Brémond, <i>INL</i>, « Doping profiles by scanning spreading resistance microscopy on core-shell p-n junction AlGaAs nanowires » <u>P14</u> : B. Gautier, <i>INL</i>, « Cartographie de la polarisation d'une couche d'amorce de nanofils de ZnO par les techniques de la microscopie en champ proche » <u>P15</u> : T. Haffner, <i>LTM</i>, « Elaboration et caractérisation de nanofils Ge_xSn_{1-x} par CVD via le mécanisme VLS » <u>P16</u> : L. Mancini, <i>C2N</i>, « Yellow MOVPE grown InGaN/GaN nanowire light-emitting diodes » <u>P17</u> : C. Durand, <i>CEA-INAC</i>, « GaN/InAlN multiple quantum well tubes »</p>

P18 : T. Cerba, *LTM*, « DSA-based process for InAs horizontal nanowires in sub-10nm FET »

P19 : A. Kapoor, *CEA-INAC*, « Green emission from In-rich core-shell InGaN/GaN multi-quantum wells along GaN nanowires »

P20 : C. Justeau, *GREMAN*, « Influence des paramètres de synthèse sur la structure des nanofils de ZnO pour la fabrication de nanogénérateurs piézoélectriques »

P21 : M. Parmar, *IMEP-LaHC*, « Development and characterization of flexible/non-flexible energy transducers based on ZnO nanowires »

P22 : A. El Kacimi, *CEA-LETI*, « Capteurs piézoélectriques capacitifs souples à base de fils de GaN verticaux : design et réalisations »

P23 : N. Pelekanos, *CEA-INAC, Univ. of Crete, IESL/FORTH*, « Random and periodic arrays of GaAs/InGaAs core-shell nanowires for photovoltaic applications »

P24 : Y. Leprince-Wang, *ESYCOM*, « ZnO nanowire based microfluidic system for photocatalytic water purification »

P25 : Y. Leprince-Wang, *ESYCOM*, « Transition-metal doped ZnO nanowires for photocatalytic water purification »

P26 : M. Capochichi-Gnambodoe, *ESYCOM*, « Gas sensing performance enhancement of transition-metal doped ZnO nanowires »

P27 : E. Bano, *IMEP-LaHC*, « Investigating the long-term stability of Si and SiC nanowires under physiological conditions »

P28 : K. Boche, *Imina Technologies*, « Characterization of the piezoelectric response of GaN nanowires for the design of flexible force sensors »

Horaire	Mercredi 15 novembre 2017
08:50	Accueil à l'ENSE3, bât. GreEn-ER, 21 rue des Martyrs 38031 Grenoble cedex 1
9:00	Session 8 : Croissance 2 (chairman : C. Durand)
9:00 – 9:30	Invité 7 : G. Patriarche, C2N, « Observation in-situ dans un microscope électronique à transmission de la croissance par jets moléculaires de nanostructures III-V »
9:30 – 9:50	Oral 23 : M. Zeghouane, Institut Pascal, « Homogeneous and high-quality InGaN nanowires with different indium compositions »
9:50 – 10:10	Oral 24 : S. Plissard, LAAS, « Defect-free Bi _{1-x} Sb _x nanowires on Si by MBE »
10:10 – 10:30	Oral 25 : V. Sallet, GEMaC, « ZnO nanowire facets transformation induced by Ga doping »
10:30	Pause-café
11:00	Session 9 : Dispositifs Piézoélectriques (chairman : V. Consonni)
11:00 – 11:30	Invité 8 : N. Gogneau, C2N, « Piezo-electric III-N nanowires for energy harvesting »
11:30 – 11:50	Oral 26 : S. Boubenia, GREMAN, « Optimisation géométrique des nanogénérateurs à base de nanofils d'oxyde de zinc »
11:50 – 12:10	Oral 27 : Y. Leprince-Wang, ESYCOM, « ZnO nanowire-based piezoelectric nanogenerator »
12:10 – 12:30	Oral 28 : E. Saoutieff, CEA-LETI, « High-Resolution fingerprint sensing with vertical piezoelectric nanowire matrices: main achievements of the PiezoMAT project »
12:30	Bilan et discussion collégiale (animateur : S. Plissard)
13:00	Repas Buffet : salle de restauration
14:00	Réunion du Bureau Nanofils Semiconducteurs
16:00	Fin des J2N